(Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25} (RE=La、Nd、Sm) セラミックスの電気特性

中山 享* 辻 久巳** 塩見 正樹** 朝日 太郎***

Electrical properties of (Bi2O3)0.75(RE2O3)0.25 (RE; La, Nd, and Sm) ceramics

Susumu NAKAYAMA* Hisami TSUJI** Masaki SHIOMI** Taro ASAHI***

A mixture of Bi₂O₃ and RE₂O₃ (RE; La, Nd, Sm) was calcined at 700 °C and then pulverized. After pressing the pulverized powders into a mold, it was sintered at 900 - 1200 °C to produce (Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25} ceramics. The bulk densities of La, Nd, and Sm were maximized at 1100 °C. X-ray diffraction revealed that La, Nd, and Sm had a rhombohedral system. The electrical conductivity increases in the order of Sm <La \le Nd, and the activation energies for conduction are almost the same.

1. 緒 言

酸化ビスマス (Bi₂O₃) は 730 °C以上の高温で蛍石型の面心 立方構造(立方晶系)の δ 型をとり、1 S・cm⁻¹程度の高い酸 化物イオン導電性を示すが、750 °C以下の温度では単斜晶系 の α 型 Bi₂O₃ で、導電率は低く P 型半導体特性を示す。この δ 型 Bi₂O₃ は Sc₂O₃型に近い構造(欠陥蛍石構造)で、蛍石型 における陰イオン位置の1/4が空になっている。したがって、 蛍石型単位胞の形式では、Bi₄O₆□₂(□は O^{2−}の空位置)と表 される。O^{2−}の空位置の配置は規則的であるが、Bi³⁺の分極率 が大きいため、この位置を O^{2−}が容易に伝導できる。この Bi₂O₃ の δ 型構造を低温まで安定化するために、Bi₂O₃に安定 化剤として 2 価(CaO、SrO、BaO)、3 価(Y₂O₃、Gd₂O₃ など の希土類酸化物)、5 価(V₂O₅、Ta₂O₅)、6 価(WO₃)金属酸 化物を固溶させることが検討されてきた。得られた固溶体の 結晶系は、ほとんどが立方晶系あるいは菱面体晶系であった。

立方晶系をとる Bi_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 などの3 価金属酸 化物、 V_2O_5 、 Ta_2O_5 などの5 価金属酸化物、6 価金属酸化物 WO_3 を安定化剤として Bi_2O_3 に固溶させた場合に見られる。 $Bi_2O_3 - Y_2O_3$ 系において、導電率の温度変化は Y_2O_3 固溶量が 25 mol%より低い場合には相変化に基づく導電率の急変がみ られるが、 Y_2O_3 の量が多い場合には比較的低温においても高 い酸化物イオン導電性を示し、広い温度範囲にわたって導電 率の急変は認められない。一方、菱面体晶系をとる Bi2O3は、 CaO、SrO、BaO、La2O3 などのような比較的イオン半径の大 きい2価あるいは3価金属酸化物を安定化剤として固溶させ た場合にみられる。安定化剤としての添加金属イオンの多く はBi³⁺の位置を置換するので、多価イオンの楊合は単位格子 中に存在する8個のO2-格子点のうち2個が空格子となって おり、δ型 Bi2O3の空格子を減少させることになる。このため δ 相が低温まで安定化されると考えられる。添加量が多くな った場合、酸化物イオン導電性が低下する。また、Y2O3のよ うな3価の金属酸化物添加の場合は、一部のY³⁺は格子間に 入ることも確認されている。安定化 Bi2O3 酸化物イオン導電 体ついての研究は、岩原らの報告後に数多くなされており [1-7, 1994年に Azad らによるレビーが報告されている ^[5]。同 じ3価でイオン半径が異なる希土類元素で安定化された Bi2O3酸化物イオン導電体は、その特性を系統的に検討するに は好都合な材料と考えられる。Bi2O3(Bi3+の8配位のイオン 半径:0.111 nm^[8])をイオン半径の小さい希土類元素(RE、 8 配位のイオン半径: Gd³⁺=0.106 nm、Dy³⁺=0.103 nm、 Y³⁺=0.1015 nm, Ho³⁺=0.102 nm, Er³⁺=0.100 nm, Yb³⁺=0.098 nm ^[8])の酸化物 Gd₂O₃、Dy₂O₃、Y₂O₃、Ho₂O₃、Er₂O₃、Yb₂O₃で 安定化された立方晶系をとる Bi₂O₃-RE₂O₃系の酸化物イオ ン導電特性については、著者らがすでに報告している^[9]。そ こで、本報告ではイオン半径の大きな希土類元素(RE、8配

令和5年8月24日受付 (Received Aug. 24, 2023)

^{*}新居浜工業高等専門学校生物応用化学科(Department of Applied Chemistry and Biotechnology, National Institute of Technology (KOSEN), Niihama College, Niihama, 792-8580, Japan)

^{**}新居浜工業高等専門学校エンジニアリングデザイン教育センター (Center for Engineering Design Education, National Institute of Technology (KOSEN), Niihama College, Niihama, 792-8580, Japan)

^{***}新居浜工業高等専門学校数理科(Faculty of Fundamental Science, National Institute of Technology (KOSEN), Niihama College, Niihama, 792-8580, Japan)

位のイオン半径:La³⁺=0.118 nm、Nd³⁺=0.112 nm、Sm³⁺=0.109 nm^[8])の酸化物La₂O₃、Nd₂O₃、Sm₂O₃で安定化されたBi₂O₃ - RE₂O₃系の酸化物イオン導電特性について検討した。

2. 実験

2-1 試料作製

(Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25}(RE=La, Nd、Sm)組成になるように、 酸化ビスマス Bi₂O₃ に所定量の水酸化ランタン La(OH)₃、酸 化ネオジム Nd₂O₃ および酸化サマリウム Sm₂O₃ を溶媒に脱 イオン水を用いて遊星ボールミル(ジルコニア製容器、ジル コニア製粉砕ボール)にて 2 時間混合した後、120 °Cで乾燥 し、アルミナルツボ中にて 700 °C-2 時間にて熱処理した。 熱処理物は、ジルコニア製乳鉢にて粗粉砕後、遊星ボールミ ル(ジルコニア製容器、ジルコニア製粉砕ボール)にて微粉 砕した。120 °Cで乾燥後、100 MPa の金型プレス機にて φ 10 mm の円盤状に成型し、電融ジルコニア粗粉末を敷いた Al₂O₃ セッター上にて 900~1200 °Cの電気炉中にて 2 時間焼結を行 った。

2-2 各種測定

各試料の破断面の微細組織を走査型電子顕微鏡(SEM)に て観察した。各試料をジルコニア乳鉢中にて粉砕した後、X 線回折装置(XRD)によりCuKa線を用いて20=20~60°の 範囲で室温にてXRD 測定した。さらに、1000℃まで昇温し 10分維持した後、XRD 測定した。その後、降温しながら900、 800、700、600、500℃の各温度で10分維持した後、XRD 測 定した。電気特性(イオン導電性)は、1100℃で焼結した円 盤状の各試料の両面にPtペーストとPt線を用いてPt電極と Ptリード線を取り付け1000℃で熱処理した。インピーダン スメーターを用いて300~600℃の範囲で電気伝導度を測定 し、得られた結果からイオン導電率および見掛けの活性化エ ネルギーを求めた。

3. 結果及び考察

3-1 焼結性

焼結性は嵩密度の測定および SEM による微細組織の観察 で判断した。各試料の嵩密度は、安定化剤に La、Nd、Sm を 用いた共に 1100 ℃で最大となった。

Fig.1 に、1100 ℃で焼結した(Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25} (RE=La、 Nd、Sm) セラミックスの破断面の SEM 写真を示す。各試料 共によく緻密化が進んでいることがわかる。結晶粒のサイズ は、La > Nd > Sm の順に小さくなる傾向が認められた。



Fig.1 1100 ℃で焼結した(a) (Bi₂O₃)0.75(La₂O₃)0.25、(b) (Bi₂O₃)0.75(Nd₂O₃)0.25、(c) (Bi₂O₃)0.75(Sm₂O₃)0.25 セラミックスの 破断面の SEM 写真.

3-2 結晶構造

XRD 解析と ICDD カードにより結晶系を決定した。1100 ℃ で焼結した(Bi₂O₃)0.75(La₂O₃)0.25 の XRD 結果を Fig.2 に示す。 室温では菱面体晶系であることがわかった。また、高温 XRD 結果においても、室温から 1000 ℃では XRD パターンに変化 が認められないことより、1000 ℃以下では菱面体晶系で安定 化 されていることがわかった。(Bi₂O₃)0.75(Nd₂O₃)0.25 の (Bi₂O₃)0.75(Sm₂O₃)0.25 も同様な結果であった。



Fig.2 1100 ℃で焼結した(Bi₂O₃)_{0.75}(La₂O₃)_{0.25} セラミックスの 高温粉末 XRD 結果.

3-3 イオン導電性

1100 ℃で焼結した(Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25} (RE=La、Nd、Sm) セラミックスについて、複素インピーダンス解析より求めた 電気特性(イオン導電性)に関する結果を Fig.3 および Table 1にまとめた。複素インピーダンスプロットは、低温域にお いては原点を通る円弧とスパイクス(円弧の立ち上がり部) が観測された。スパイクスは電極界面の二重層容量によるも のであるが、等価回路は簡略化して抵抗成分と容量成分が並 列に組合わさったものと考えられる。高温域においてはスパ イクスのみが観測され、抵抗成分が小さくなった結果として 容量成分が無視できるようになり、等価回路としては抵抗成 分と電極界面の二重層容最が直列に組合わさったものとみ なせる。抵抗成分は、低温域においては円弧を実軸に外挿す ることにより決定し、高温域においてはスパイクスと実軸と の交点とした。添加した希土類元素(La、Nd、Sm)の違いに よる全イオン導電率(バルク抵抗+粒界抵抗)の変化は、最 も高い導電率が Nd で得られ、La と Sm の順に低くなった。 300~600 ℃の温度範囲ではアレニウスプロットに変曲点は 観察されず、3-2の高温 XRD より結晶系の変化が観測なさな かった結果と一致する。希土類元素のイオン半径の違いとア レニウスプロットにより求められたイオン導電に関する見 掛けの活性化エネルギーの関係をみると、Table 1 からわかる ように、活性化エネルギーは 80~83 kJ·mol⁻¹ 辺りでほぼー 定であった。立方晶を示す(Bi2O3)0.75(RE2O3)0.25 (RE=Dy、Y、 Ho、Er、Yb) において認められた希土類元素のイオン半径と 活性化エネルギーの間にみられた凸の放物線を示す規則的 な関係は認められなかった^[8]。



Fig.3 1100 ℃で焼結した(a) (Bi₂O₃)0.75(La₂O₃)0.25、(b) (Bi₂O₃)0.75(Nd₂O₃)0.25、(c) (Bi₂O₃)0.75(Sm₂O₃)0.25 セラミックスの イオン導電に関するアレニウスプロット.

Table 1 1100 ℃で焼結した(Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25}(RE=La、Nd、 Sm)セラミックスのイオン導電に関する見掛けの活性化エネ ルギーEa と各温度でのイオン導電率 σ

RE	Ea	$\sigma / S \cdot cm^{-1}$		
	/ kJ∙mol⁻¹	400 °C	500 °C	600 °C
La	80.4	—	2.88×10 ⁻³	7.20×10 ⁻²
Nd	82.9	9.16×10 ⁻⁴	3.85×10 ⁻³	1.47×10 ⁻²
Sm	82.0	5.00×10 ⁻⁴	2.76×10 ⁻³	8.57×10 ⁻³

4. 結 言

Bi₂O₃および RE₂O₃ (RE=La、Nd、Sm)の混合物を700 ℃ 仮焼した後、解砕後に900~1200 ℃で焼成して (Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25}セラミックスを作製した。嵩密度は、La、 Nd、Sm 共に1100 ℃焼結品で最大になった。X線回折から La、Nd、Sm 共に、菱面体晶系であった。導電率はSm < La \leq Ndの順に高くなり、イオン導電に関する見掛け活性化エ ネルギーはほぼ同じであった。

参考文献

- T. Takahashi, H. Iwahara, Y. Nagai, "High oxide ion conduction in sintered Bi₂O₃ containing SrO, CaO or La₂O₃", *Journal of Applied Electrochemistry*, Vol.2, pp.97-104 (1972).
- [2] T. Takahashi, H.I wahara, T. Arao, "High oxide ion conduction in sintered oxides of the system Bi₂O₃-Y₂O₃", *Journal of Applied Electrochemistry*, Vol.5, pp.187-195 (1975).

- [3] T. Takahashi, T. Esaka, H. Iwhara, "High oxide ion conduction in sintered oxides of the system Bi₂O₃-Gd₂O₃", *Journal of Applied Electrochemistry*, Vol.5, pp.197-202 (1975).
- [4] T. Takahashi, H. Iwhara, "Oxide ion conductors based on bismuthsesquioxide", *Materials Research Bulletin*, Vol.13, pp.1447-1453 (1978).
- [5] A. M. Azad, S. Larose, S. A. Akbar, "Bismuth oxide-based solid electrolytes for fuel cells", *Journal of Materials Science*, Vol.29, pp.4135-4151 (1994).
- [6] H. M. Sammes, G. A. Tompsett, H. Nafe, F. Aldinger, "Bismuth based oxide electrolytes – structure and ionic conductivity", *Journal of the European Ceramic Society*, Vol.19, pp.1801-1826 (1999).
- [7] M. J. Verkerk, A. J. Burggraaf, "High oxide ion conduction in sintered oxides of the Bi₂O₃-Dy₂O₃ system", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol.128, pp.75-82 (1981).
- [8] R. D. Shannon, C. T. Prewitt, "Effective ionic radii in oxides and fluorides", *Acta Crystallographica B*, Vol.25, pp.925-946 (1969).
- [9] S. Nakayama, "Electrical properties of (Bi₂O₃)_{0.75}(RE₂O₃)_{0.25} ceramics (RE = Dy, Y, Ho, Er and Yb)", *Ceramics Internatinal*, Vol.28, pp.907-910 (2002).